◎公開特許公報(A)

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)11月19日

H 01 L 21/304 B 24 B 37/04 3 2 1 E

8831-4M 6581-3C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

69発明の名称

Sint Cl. 5

回転研磨装置

纽特 顧 平2-58605

公出 頭 平2(1990)3月8日

の発明 者

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

20代理 人 弁理士 内原

明知 音

1. 発明の名称 回転研磨装置

2. 特許請求の範囲

回転板を用いた資店被費であって、回転板上の研磨パッド表面に段差を有し、研磨加工時にその 設差高さを制御する機構を有することを特徴とす る研磨装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

高密度集積回路装置の製造に用いられる半導体 基板の加工技術に関する。

〔従来の技術〕

半導体象積回路装置の製造には、非常に厳しく 寸法精度が管理された半導体高板が用いられている。これは、この集積回路装置の微細加工技術と して完学的なパターン毎写技術が用いられており、 良好な転写がなされるためには、対象となる半導体基板の加工構度が、光学系の焦点硬度内に十分 管理されていることが必須となるためである。

しかも、その集積回路装置は半導体基板の表面 に形成されるため、基板加工には、単に厚さ、寸 法だけでなく、表面の平滑度も強く要求される。

このため、半導体基板の表面を鉄面研磨するの が一般的である。

従来この機な鏡面研磨手法として、第2回に示 寸様な函転板を用いた手法がある。

コロイダルシリカ等の数小な低粒物を含んだが 断度を介して、金属回転板1の上に貼付されたが リエステル等の樹脂成形による厚さ1ミリメート ル程度の研磨ペッド2とシリコン・ウェハー3と の接触により値面平坦化を通成するものである。 しかもこのとき、ウェハー加圧押え4により 重を印加する。このような手法では、研磨対象物 の初期の変面平坦度に応、研磨パッドの表面凹凸を、 研密加工の追行とともに変えていることが要求さ

特問平3-259520(2)

れる。なぜならば、研磨対象物の加工初期の狙い 表面に対して、細かい表面凹凸の研磨パッドを用いることは、平坦化する上で効率が悪く、また研 層対象物の最終加工段階で、表面凹凸の狙い研磨 パッドを用いることは、最終形状の平坦度がその 研磨パッド形状に影響されるという観点から、不 着切なものとなる。

粗い表面の研磨パッドを達成するために、「エンボス加工」と言うような無成型による樹脂表面の塑性加工を用いた段差形成がされていた。

[発明が解決しようとする課題]

従来、このような状況から幾つかの異なる種類 の研磨パッドを用意し、段階的に研磨加工に適用 するという手法がとられていた。

しかしながら、このような手法では研磨ペッド を貼り替えたり、複数の研磨装置に研磨対象物で ある半導体差板を装着するなど、工器が頒載とな る問題点があった。

[課題を解決するための手段]

本発明の回転研磨装置では、研磨パッド材質を

ログラムとした。この時の圧力とパッド段差の関 係を測定したところ、第3図のグラフが得られた。 次に、この装置を用いて、直径10インチのシ リコン・ウェハーの魏面研磨を行なった。平均粒 径10ミクロンのコロイダルシリカを4重量パー セント含み、またアンモニアを用いてpH値を 9.5として水溶液を調整し、研磨液とした。回転 板の回転数を毎分20回、ウェハーの加圧を一平 方センチょートル当り30グラムに設定し、また 研磨パッドの段差形成に対する加圧値を表1の加 くに設定して統面研磨を連続的に行なった。同時 に、従来の装置においても研磨パッドを同じくし て比較を行なった。この時の、ウェハー変面の凹 凸を触針式の表面狙さ計により測定した結果が、 第4回である。本発明による装置では、約8分 3 0 秒後には鏡面が選成されたのに対して、従来 装置では、20分以上の研磨時間が必要であった。 このことは、本発明の機構の有効性を示す結果で

替えるのではなく、研磨パッド裏面より圧力を加 えることにより局所的に変形させることにより良 差形状を達成し、しかもその圧力の印加を外部の 制御機構により調節することにより、各研磨段階 での最適な研磨パッドの表面状態を確保するとい う手段を用いている。

〔実集例〕

本発明について図面を用いて説明する。

第1図は、本発明の一実施例の示す説明図である。本発明の金属製の回転板上部14には、 直径 6ミリメートルの貫通孔12を1センチメートル 当り0.5個の密度で配置した。この上に、 厚さ 0.8ミリメートルのポリエステル製の研磨パッド 11を貼付した。回転板の下部13には、 気密性を保持可能な軸受け17を配し、外部の圧縮空気を供給する。

また、圧力調整器 1.5 を設置し外部からの電気 信号で圧力調整を可能とした。その圧力調整値の 範囲は、1平方センチメートル当り0.1~1 0 キ

研磨時間	0~5分	2分~4分	4分以上
圧 力 値	1 0 kg/cd	2 kg/cal	0.3 kg/cal

表

第5 図は、本発明の第二の実施例を示す断面図である。突起状の押しピンを有する押しピンを有する押しピンを有する押しピンを有する押しピンを有する押しピンを有する押しピンを有する押したが多いでは、圧縮空気の代りに油圧機構をした。研磨パッドと直接接することをできた。研磨パッドと直接接することがないため、表面側への油の汚染が防止できたためである。また、この機構によっても第一の実施例と同様の効果が確認された。

第6図に、本発明の第三の実施例の構造断面図を示す。研磨パッド31を押し上げる押しピン33の駆動力として、ソレノイド・コイル34を用いた例について述べる。外部からの電流の供給方法としては、樹脂を用いた絶数体の回転板下部32に電価36を配置した。外部からは、給電端子37を有する給電板38との接触により、ソレ

特開平3-259520(3)

ノイド駆動電流の経路を形成した。またこの例では、第7回に示すように、回転数と同期させて、コイル電流を断続することにより、ウェハーが接触している部分のみに、研磨パッド31に段差形状を形成できるという特徴を有している。ことは、消費電力の低減ばかりでなく、研磨パッドする場合の増大についても、常時段差形状を保持する場合に比べ、3~5倍程度の寄与ができることがわかった。

[発明の効果]

以上述べてきたように、本発明の研磨装置では 単一の研磨パッドで広範囲の段差形状を有するた め一回の継続的な研磨処理で、短研磨から最終研 磨までが可能となった。このため、ウェハーの自 動装填装置と組み合わせて、単一工程の自動研磨 装置が達成できたなどの実用面での大きな経済被 及効果が得られた。

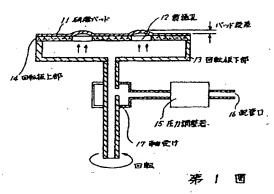
4. 図面の簡単な説明

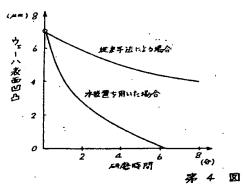
第1日は、本発明の第一の実施例を示す構造断

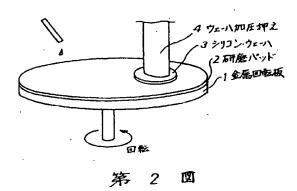
面図、第2図は、従来技術による研磨装置を示す 説明図、第3図は、本発明の研磨装置における印 加圧力とパッド段差の関係を示すグラフ、第4図 は、本発明の研磨装置による研磨性能の説明図、 第5図は、本発明の第二の実施例を示す構造断面 図、第6図は、本発明の第三の実施例を示す構造 断面図、第7図は、本発明の第三の実施例におけ る段差制御サイクルを示す説明図である。

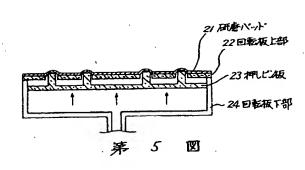
1 ……金属回転板、2 ……研磨パッド、3 ……シリコン・ウェハー、4 ……ウェハー加圧押え、11、21、31 ……研磨パッド、12 ……質通孔、14、22、32 ……回転板上部、13、24、35 ……回転板下部、15 ……圧力調整器、16 ……配管口、17 ……軸受け、23 ……押しピン板、33 ……押しピン、34 ……ソレノイド・コイル、36 ……電極、37 ……給電端子、38 ……給電板、

代理人 弁理士 内 原 音









特開平3-259520(4)

